

12月6日付けで公布しました、輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達（輸出注意事項29第27号）について、以下の点を訂正します。

- ①改正後の1の項の爆発物の解釈の欄の又中「又は当該粉末」を「若しくはこれらを混合したもの又はこれらの粉末」に改め、同欄の注ハ中「成型品とは、」の下に「例えば、」を加える。
- ②改正後及び改正前の5の項の貨物等省令第4条第四号ト中のトウを位置決めし、及びラミネートする作業を行うものの解釈の欄の注中「織布状」を「織布状」に改める。
- ③改正後の7の項の「膜形集積回路」の下に「光集積回路」を、「モノリシックマイクロ波集積回路」の下に「記録」の解釈を加える。

誤

改正後				改正前			
輸出令別表第1の項	輸出令別表第1中解釈を要する語	解 釈		輸出令別表第1の項	輸出令別表第1中解釈を要する語	解 釈	
1	(略)	(略)		1	(略)	(略)	
	爆発物	次のいずれかに該当するものを含む。 イ～リ (略) 又 反応材料であって、次のいずれかに該当する粉末(粒子の最大径が二五〇マイクロメートル未満のものに限る。)又は当該粉末からなる成			爆発物	次のいずれかに該当するものを含む。 イ～リ (略) <u>(新設)</u>	

型品

- (一) アルミ
ニウム
- (二) ニオブ
- (三) ほう素
- (四) ジルコ
ニウム
- (五) マグネ
シウム
- (六) チタン
- (七) タンタ
ル
- (八) タング
ステン
- (九) モリブ
デン
- (十) ハフニ
ウム

注：イ 反応材料
とは、高い
せん断速度
でのみ発熱
反応を発生
させ、弾頭
のライナー
又は外殻と
して使用す
るために設
計されたも
のをいう。

ロ 粉末とは
、例えば、
高エネルギー
ボールミ
ルによる粉

		<p><u>碎過程を経て製造されたものをいう。</u></p> <p>ハ <u>成型品とは、選択的レーザー焼結で製造されたものをいう。</u></p>			
	(略)	(略)		(略)	(略)
5	(略)	(略)		5	(略)
	<p>貨物等省令第4条第四号ト中のトウを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもの</p>	<p>次のイ及びロに該当する能力を有するものをいう。</p> <p>イ 1本以上のフィラメントバンド（幅が<u>25.4</u>ミリメートル以下のものに限る。）を位置決めし、及びラミネートできるもの</p> <p>ロ (略)</p> <p>注：フィラメントバンドとは、繊維に完全又は部分的に樹脂を含浸したプリプレグであって、単一で連続したテープ状又は繊維状若しくは織布状のものをいう。<u>完全又は部分的に樹脂を含浸したフィラメントバンドには、熱接着性のドライパウダーでコーティングしたものを含む。</u></p>		<p>貨物等省令第4条第四号ト中のトウを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもの</p>	<p>次のイ及びロに該当する能力を有するものをいう。</p> <p>イ 1本以上のフィラメントバンド（幅が<u>25</u>ミリメートル以下のものに限る。）を位置決めし、及びラミネートできるもの</p> <p>ロ (略)</p> <p>注：フィラメントバンドとは、繊維に完全又は部分的に樹脂を含浸したプリプレグであって、単一で連続したテープ状又は繊維状若しくは織布状のものをいう。</p>
	(略)	(略)		(略)	(略)
7	(略)	(略)		7	(略)

<u>膜形集積回路</u>	<u>厚膜又は薄膜の堆積によって、絶縁基板上に回路素子及び金属相互接続のレイを形成したものをいう。</u>	(新設)	(新設)
<u>三次元集積回路</u>	<u>半導体ダイ又はアクティブデバイス層の集合体であって、デバイス層同士の相互接続を形成するためのインターポージャー（電気的な接続を可能にするためのインターフェースをいう。）、基板、ダイ又は層を完全に貫通するビアを有するものをいう。</u>	(新設)	(新設)
<u>モノリシックマイクロ波集積回路</u>	<u>マイクロ波又はミリ波の周波数で作動するモノリシック集積回路をいう。</u>	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)

正

改 正 後			改 正 前		
輸出令別表第1の項	輸出令別表第1中解釈を要する語	解 釈	輸出令別表第1の項	輸出令別表第1中解釈を要する語	解 釈
1	(略)	(略)	1	(略)	(略)
	爆発物	次のいずれかに該当するものを含む。 。		爆発物	次のいずれかに該当するものを含む。 。

イ～リ (略)
又 反応材料であ
って、次のい
れかに該当する
粉末(粒子の最
大径が二五〇マ
イクロメートル
未満のものに限
る。)若しくは
これらを混合し
たもの又はこれ
らの粉末からな
る成型品
(一) アルミ
ニウム
(二) ニオブ
(三) ほう素
(四) ジルコ
ニウム
(五) マグネ
シウム
(六) チタン
(七) タンタ
ル
(八) タング
ステン
(九) モリブ
デン
(十) ハフニ
ウム
注：イ 反応材料
とは、高い
せん断速度
でのみ発熱
反応を発生

イ～リ (略)
(新設)

		<p>させ、弾頭のライナー又は外殻として使用するために設計されたものをいう。</p> <p>ロ 粉末とは、例えば、高エネルギーボールミルによる粉碎過程を経て製造されたものをいう。</p> <p>ハ 成型品とは、例えば、選択的レーザー焼結で製造されたものをいう。</p>			
	(略)	(略)		(略)	(略)
5	(略)	(略)		5	(略)
	貨物等省令第4条第四号ト中のトウを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもの	<p>次のイ及びロに該当する能力を有するものをいう。</p> <p>イ 1本以上のフィラメントバンド（幅が<u>2.5. 4</u>ミリメートル以下のものに限る。）を位置決めし、及びラミネートできるもの</p> <p>ロ (略)</p>			<p>貨物等省令第4条第四号ト中のトウを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもの</p> <p>次のイ及びロに該当する能力を有するものをいう。</p> <p>イ 1本以上のフィラメントバンド（幅が<u>2.5</u>ミリメートル以下のものに限る。）を位置決めし、及びラミネートできるもの</p> <p>ロ (略)</p>

		注：フィラメントバンドとは、繊維に完全又は部分的に樹脂を含浸したプリプレグであって、単一で連続したテープ状又は繊維状若しくは織布状のものをいう。 <u>完全又は部分的に樹脂を含浸したフィラメントバンドには、熱接着性のドライパウダーでコーティングしたものを含む。</u>
	(略)	(略)
7	(略)	(略)
	<u>膜形集積回路</u>	<u>厚膜又は薄膜の堆積によって、絶縁基板上に回路素子及び金属相互接続のレイを形成したものをいう。</u>
	光集積回路	(略)
	<u>三次元集積回路</u>	<u>半導体ダイ又はアクティブデバイス層の集合体であって、デバイス層同士の相互接続を形成するためのインターポザー（電気的な接続を可能にするためのインターフェースをいう。）、基板、ダイ又は層を完全に貫通するビアを有するものをいう。</u>
	<u>モノリシックマイクロ波集積回路</u>	<u>マイクロ波又はミリ波の周波数で作動するモノリシック集積回路をいう。</u>
	記録	<u>アナログデジタル変換した連続的なデータをメモリに保存することをいう。</u>

		注：フィラメントバンドとは、繊維に完全又は部分的に樹脂を含浸したプリプレグであって、単一で連続したテープ状又は繊維状若しくは織布状のものをいう。
	(略)	(略)
7	(略)	(略)
	<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>
	光集積回路	(略)
	<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>
	<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>
	<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>

	(略)	(略)		(略)	(略)
--	-----	-----	--	-----	-----